



「GaN コンタクト技術」

◇ 日時：2022年3月4日(金) 13:00～16:30

◇ 場所：Zoomによるオンライン開催

GaN パワーデバイスの実用化に向けた開発が活発に行われている。低オン抵抗や安定動作の実現には、良好なコンタクトの形成が不可欠であるが、GaN においては金属/GaN 界面での現象について十分な理解が進んでいないのが現状である。そこで、金属/GaN 界面評価や p-GaN オーミックコンタクト研究に関するオーバービューを足掛かりに、参加者からの情報提供を頂きながら、GaN コンタクト技術に関わる専門家が直面している課題を明らかにし、今後の研究の方向性について議論する。

.....プログラム.....

13:00～13:10 開会の挨拶、本日の進行説明

13:10～13:40 p-GaN オーミックコンタクトの開発(仮題)

小出 康夫 (NIMS)

13:40～14:10 GaN ショットキー接合評価(仮題)

塩島 謙次 (福井大)

14:10～14:40 GaN へのトンネル接合によるコンタクト形成(仮題)

竹内 哲也 (名城大)

14:40～14:50 休憩

14:50～16:20 参加者からの情報提供と討議

16:20～16:30 閉会の挨拶

.....

■参加について: GaNのコンタクト形成技術について、全員参加で議論を行う討論会です。情報収集のみの参加はお断りします。WEBから参加申し込みを行っていただく際に、議論できる内容や取り組んでいる研究の概要、提供可能な話題などについて事前質問入力フォームに記述いただきます。参加申し込み多数の場合は、申し込み時のアンケートをもとに選定させていただきます。また、参加者によるディスカッションを活発にするため、当日プレゼン用スライドを1～3枚ご準備頂きます。予めご了承ください。

■参加受付: WEB参加受付システム([ここをクリック](#))から参加登録をお願いします。締切2022年2月14日(月)。本案内が印刷物の場合、<https://formok.com/f/mtqpm67s> よりアクセス下さい。

■参加費: (消費税込)参加申込み後、オンライン決済についてご案内致します。

先進パワー半導体分科会会員: 2,000円、一般: 4,000円、学生: 1,000円

*2022年2月25日(金)に配布資料を配信予定です。以降の返金は申し受けできません。

■問い合わせ先:

新井 学(名古屋大学) TEL: 050-3625-5455 e-mail: marai@imass.nagoya-u.ac.jp

田中 亮(富士電機) TEL: 042-585-6598 e-mail: tanaka-ryou@fujielectric.com